■ 公募情報

公募No.	2027R-10
職種	有期研究員
部署	未来ICT研究所小金井フロンティア研究センターグリーンＩＣＴデバイス研究室
研究テーマ	酸化ガリウム電子デバイスの研究開発
研究テーマ要旨	新規ワイドギャップ半導体である酸化ガリウム（Ga_2O_3）を用いた電子デバイスの基盤技術と、その性能を最大限に引き出すための熱管理技術の研究開発を行う。放射線下や高温下などの過酷な環境下で安定して高周波動作するデバイスの実現を目指し、デバイスの設計・作製プロセスの開発、DC/RF特性評価及び信頼性評価を主体的に推進する。研究計画の立案から実験、結果の解析、論文・学会発表による成果発信までを担当する。
自発的な研究活動等の実施に関して	機構内外の競争性を有する研究資金（科研費等）への申請資格があります。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2の対象業務該当の有無	【有】
応募要件	【必須】 理工学分野の博士号を取得（取得見込みを含む）又はこれと同等の研究能力を有すると認められる者 半導体電子デバイスに関する研究開発の知識と経験を有する者 研究業務への高い意欲を持ち、関係者と協力して創造的な研究開発を実施できる者 【あれば望ましい】 高周波トランジスタ（MOSFET、HEMT等）の研究開発経験 耐放射線又は高温動作半導体デバイスの研究開発経験 ワイドギャップ半導体（SiC、GaN、Ga_2O_3等）のデバイス物理に関する知識 クリーンルームでの半導体デバイス作製プロセスの経験 デバイスシミュレーション（TCAD等）又は熱解析の経験 査読付き国際学術誌への論文発表の経験
募集人員	2 人
本年度契約期間	採用日　～　令和10年3月31日（更新の可能性：有り）
更新した場合の雇用期間（又は期日）	一定の条件を満たした場合に、採用日より最長5年
給与(本給)	541,000円　～　558,000円/月 本給は学歴や職務経験等を考慮し決定します。ただし、本給については、国家公務員の給与に準拠していることから国家公務員の給与に改正があり、当機構労働組合等の合意後に本給の改定が生じた場合は変更する。
勤務地名称	本部 (東京都小金井市)
勤務頻度	週5日（週37時間30分勤務）　※時間外労働有

※従事する業務及び勤務地の変更の範囲：原則として変更無し
※部署の名称、勤務地の名称、及び研究テーマや研究テーマ要旨内の表現に関しては、組織改編等により変更となる場合があります。

NICT有期雇用職員公募情報：https://www.nict.go.jp/employment/apply.html